

Пресс-тур в Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН:
разработки в интересах промышленности, разработки для перспективной
электроники

12 мая в 9.15 по адресу Пирогова, 30 состоится пресс-тур в Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН

Ученые Института расскажут о разработках, ведущихся в интересах промышленности, важных для импортозамещения. Это:

- создание полупроводниковых компонентов для оптоволоконных систем связи, систем передачи данных через открытое пространство,
- разработка технологии синтеза кристаллических пленок на основе нитрида галлия алюминия на кремниевых подложках. В РФ эта технологическая задача еще не решена. Такой полупроводниковый материал нужен при создании силовых транзисторов, систем беспроводной зарядки и других применений.

Также специалисты Института расскажут и о фундаментальных работах: исследовании свойств новых материалов, перспективных для создания электроники будущего.

Во время пресс-тура будут представлены исследования, которые ведутся в молодежных лабораториях и проекты, выполняемые в рамках совместных грантов Российского научного фонда и правительства НСО.

После посещения лабораторий запланирован пресс-подход, участие в котором примут: министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Витальевич Васильев, директор ИФП СО РАН академик РАН Александр Васильевич Латышев.

Спикеры пресс-тура:

Олег Евгеньевич Терещенко, доктор физико-математических наук заведующий лабораторией физики и технологии гетероструктур ИФП СО РАН

Владимир Андреевич Голяшов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории физики и технологии гетероструктур ИФП СО РАН

Денис Сергеевич Милахин, кандидат физико-математических наук, заведующий молодежной лабораторией аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии GaN гетероструктур на подложках кремния для силовых и СВЧ транзисторов

Максим Сергеевич Аксенов, кандидат физико-математических наук, заведующий молодежной лабораторией физико-технологических основ создания фотоприёмных устройств на основе полупроводников АЗВ5

Дмитрий Владимирович Гуляев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатория молекулярно-лучевой эпитаксии соединений АЗВ5 ИФП СО РАН

Аккредитация обязательна.

Контакты: пресс-секретарь ИФП СО РАН Дмитриева Надежда Валерьевна, pressa@isp.nsc.ru, тел: +7913-373-6776,

пресс-секретарь Министерства науки и инновационной политики НСО Белых Станислав Альбертович, bsal@nso.ru, тел. +7 (383) 238-75-51, тел/WhatsApp/Viber: +7913-474-47-27

Транспорт для журналистов будет: микроавтобус отправится в 8.15 от крыльца
Правительства НСО со стороны ул. Свердлова